科学研究費助成事業

. . . .

研究成果報告書



平成 27 年 6 月 24 日現在

機関番号: 82108
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2013~2014
課題番号: 2 5 6 2 0 0 7 0
研究課題名(和文)分子で創る超格子: 分子ヘテロ界面形成過程の直接観察からのアプローチ
研先課題名(央文) Direct observation of the growth process of hetero-molecular interface
研究代表者
若山 裕(Wakayama, Yutaka)
独立行政法人物質・材料研究機構・国際ナノアーキテクト_クス研究拠点・MANA研究者
研究者番号:00354332
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):本研究は異種分子を積み重ねた「分子超格子」の創生技術の確立を目的にした。まずn型有 機半導体のフッ素化フタロシアニンとp型有機半導体のペンタセンの組み合わせでSTM観察による界面の形成過程解析に 取り組んだ。第一層目をフタロシアニン、第二層目をペンタセンとした場合には混晶二重層が形成された。蒸着する順 番を逆にするとペンタセン層の格子間にフタロシアニンが挿入された固溶相が形成された。これらは両分子間の水素結 合によって安定な構造を取るべく、異種分子が混合することも明らかにした。最後に混合相を形成しないペリレン誘導 体とチオフェン分子の組み合わせで平坦かつ急峻な異種分子へテロ界面の形成に成功した。

研究成果の概要(英文): The main purpose of this study is to establish a growth process of molecular superlattice, where heterogeneous molecular layers are stacked layer-by-layer in a single molecular level. First, STM observation was carried out to clarify the formation process of hetero-interface of fluorinated phthalocyanine and pentacene as a typical combination of n-type and p-type organic semiconductors. We found that these molecules formed well-mixed bilayers, e.g., molecular alloy bilayer and solid solution, which were depending on the sequence of deposition. Here, hydrogen bonding between fluorine atoms and hydrogen atoms were found to be responsible to these mixed layer growth, that is, these intermolecular interaction prevented well-defined molecular hetero-interface. Based on these findings, we adopted a perylene derivative and thiophene oligomer, which have no intermolecular interface with flat interface.

研究分野: 有機半導体工学

キーワード: 超格子 有機半導体 ヘテロ界面 走査型トンネル電子顕微鏡

1.研究開始当初の背景

(1) 有機デバイスでは電荷の分離や再結 合などの電荷プロセスがヘテロ界面で起き ている。そのためヘテロ界面の精密な設計 が重要なことは論を待たない。しかし実際 のデバイスは簡便な蒸着技術で作製されて おり、肝心のヘテロ界面の平坦性や分子配 向まで考慮されていない。これに対し超平 坦分子界面や分子超格子が実現できれば、 電荷プロセスの高効率化(再結合の抑制、 電荷分離の促進、キャリア輸送の向上)や キャリアの閉じ込め効果と高効率発光など 従来の無機半導体で実現されてきた量子効 果が分子材料でも期待できる。

(2) これに対し我々は異種分子が混成し た分子膜の STM 解析を進めてきた。その 中で異種分子を順次蒸着すると固相反応を 起こしつつヘテロ界面が形成されているこ とを明らかにしてきた。一方で、分子層を 一層ずつ積層させる技術開発に取り組んで きた結果、熱平衡に近い状態で成膜できる 「ホットウォール蒸着法」を確立した(特許 第 5077919 号)。これらの研究から、STM 解析と積層技術を融合させれば分子ヘテロ 界面の精密設計が実現でき、分子を使った 超格子の作製や電荷プロセスの高効率化に 発展できるとの着想に至った。

2.研究の目的

超平坦な分子界面や分子超格子を作製する 技術を確立する。これにより電荷プロセス の高効率化やキャリアの閉じ込め効果と高 効率発光など従来の無機半導体で実現され てきた量子効果を分子材料でも実現できる ことを実証する。

3.研究の方法

(1) 期間前半には STM でのリアルタイム 解析に注力した。p型としてペンタセン、n 型半導体としてフッ素化フタロシアニンの 二種類の分子を順番に蒸着しながら、その 場で STM 観察して界面形成の様子を直接 観察した。予備的実験では異種分子間で相 互拡散や混合相の形成が起きることが分か っていた。その具体例を右上段に示す。そ こで混合比を系統的に変えながら混合層が どのように形成されるかを解析した。

(2) 期間後半では分子超格子構造の作製 に取り組んだ。ここでは異種分子間の固相 反応を避けるため特にn型半導体にはアル キル鎖が付けられたものを選択し、直接的 な相互作用を抑制した。その分子群の分子 構造とその電子準位(HOMO - LUMO レベ ル)を右中段に示す。

4.研究成果

(1) STM 観察による解析結果を右下段に 示す。混合比の違いにより固溶体・混晶相・





相分離および析出といったさまざまな固相 反応と混合相を形成することが分かった。 さらにこの形成機構を理論計算から解析し たところ異種分子間に形成される水素結合 がその駆動力となっていることも分かった。 従来の有機素子に使われている有機半導体 ではこの様な固相反応が起きていることが 容易に想像できる。この様に分子の組み合 わせと蒸着する順番、混合する比率などに より分子レベルで平坦なヘテロ界面が形成



PTCDI-C₈ on QT T_s= 115°C

できないため、素子特性の阻害要因となり 得る。そのため素子特性の向上を目指す場 合には分子構造の適切な選択が求められる。

(2)これらの結果を受けて、p型・n型半導 体の各組み合わせで単一分子層を積層した ときの AFM 像を上図に示す。ここで示す とおり、蒸着条件を最適化すれば単一分子 レベルで平坦な積層構造が形成できること が分かった。なおこれらの積層構造はいず れも独自に開発したホットウォール蒸着法 で作製した。この手法は一時間に一分子層 という極めて低速の蒸着速度を制御できる ためこのような単一分子レベルでの積層が 可能になった。

(3) 最後に p 型半導体としてクウォーテリ レン分子を、n 型半導体として PTCDI-C8 分子を選択して、これらを交互積層した分 子超格子の結果を下図に示す。各層を一層 ずつ積層する毎に AFM 像を観察して平坦 な表面を持つ単一分子層が形成されている ことを確かめて、かつその分子層厚みから 分子の配向までを決定している。右図には 各層表面の AFM 像を、左図にはこうして形 成された分子超格子構造の模式図を示して いる。なお、こうして作製された分子超格 子構造のエネルギーダイアグラムを光電子 分光法と光学吸収スペクトルにより評価し た。その結果、各分子独自の電子準位でへ テロ界面が接合されていることが分かった。 すなわち前頁に示したような各分子の電子 準位がそのままヘテロ界面で接合されてい る。これは界面間での電荷移動が抑制され ていることを示している。この結果から、 無機半導体と同様のバンドエンジニアリン グが有機半導体で初めて実現された。



5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

Asymmetric response toward molecular fluorination in binary

copper-phthalocyanine/pentacene assemblies D. G. de Oteyza, J. M. Garcia-Lastra, E. Goiri, A. El-Sayed, Y. Wakayama, J. E. Ortega

J. Phys. Chem. C 118 (2014) 18626-18630. 査読

有り DOI: 10.1021/jp506151j

Exciton dynamics at the heteromolecular interface between

N,N-dioctyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide and quaterrylene, studied using time-resolve photoluminescence Nobuya Hiroshiba, Kenta Morimoto, Ryoma

Hayakawa, Yutaka Wakayama Tatsuo Mori, Kiyoto Matsuishi

AIP Advances 4 (2014) 067112-1-11 査読有り DOI:10.1063/1.4880495

Layer-by-layer growth of precisely controlled hetero-molecular multi-layers and superlattice structures

Nobuya Hiroshiba, Jonathan P. Hill, Ryoma Hayakawa, Toyohiro Chikyow, Ariga Katsuhiko, Kiyoto Matsuishi, Yutaka Wakayama

Thin Solid Films 554 (2014)74-77. 査読有り DOI: 10.1016/j.tsf.2013.03.082.

Understanding energy level alignment in donor-acceptor/metal interfaces from core-level shifts

Afaf El-Sayed, P. Borghetti, E. Goiri, C. Rogero, L. Floreano, G. Lovat, D. J. Mowbray, J. L. Cabellos, Y. Wakayama, A. Rubio, J. E. Ortega, D. G. de Oteyza ACS Nano 7 (2013) 6914-6920. 査読有り DOI: 10.1021/nn4020888

〔学会発表〕(計 2件)

International conference on Advanced Materials and Nanotechnology (Nov. 4-6, 2014, Kathmandu, Nepal) STM study on solid-state reactions in binary molecular assemblies Yutaka Wakayama

TMS2014 143th Annual Meeting & Exhibition (Feb. 16-20, 2014, San Diego, USA) STM study on solid-state reactions in binary molecular assemblies Yutaka Wakayama

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 2件) 名称: 有機半導体トランジスタ及びその製造 方法 発明者:<u>若山裕</u>、呉承俊 権利者: 物質·材料研究機構 種類:特許 番号: 特願 2014-189603 出願年月日:2014年9月18日 国内外の別: 国内 名称:デュアルゲート有機薄膜トランジスタ 発明者:<u>若山裕</u>、石黒康志、早川竜馬、安田 剛 権利者:物質・材料研究機構 種類:特許 番号:特願 2013-117654 出願年月日:2013年6月4日 国内外の別: 国内 取得状況(計 0 件) 〔その他〕 ホームページ等 http://www.nims.go.jp/kyushu/en/labo/wakayama /index.html 6.研究組織 (1)研究代表者 若山 裕 (WAKAYAMA, Yutaka)

独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノア ーキテクトニクス研究拠点・MANA 研究者

研究者番号:00354332